

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
24 février 2005 (24.02.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/017623 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ : **G03F 7/20**

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/050377

(22) Date de dépôt international : 5 août 2004 (05.08.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03504110 7 août 2003 (07.08.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **COM-
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE** [FR/FR];
31 33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).

(72) Inventeurs, et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **RABAROT,
Marc** [FR/FR]; 3, rue Casimir Brenier, F-38120 Saint

Egreve (FR). **KIPP, Mathieu** [FR/FR]; 87, rue du Général
de Gaulle, F-67120 Duttlenheim (FR). **KOPP, Christophe**
[FR/FR]; 51A, rue des Aiguinards, F-38240 Meylan (FR).

(74) Mandataire : **POULIN, Gérard?**; Brevatôme, 3, rue du
Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

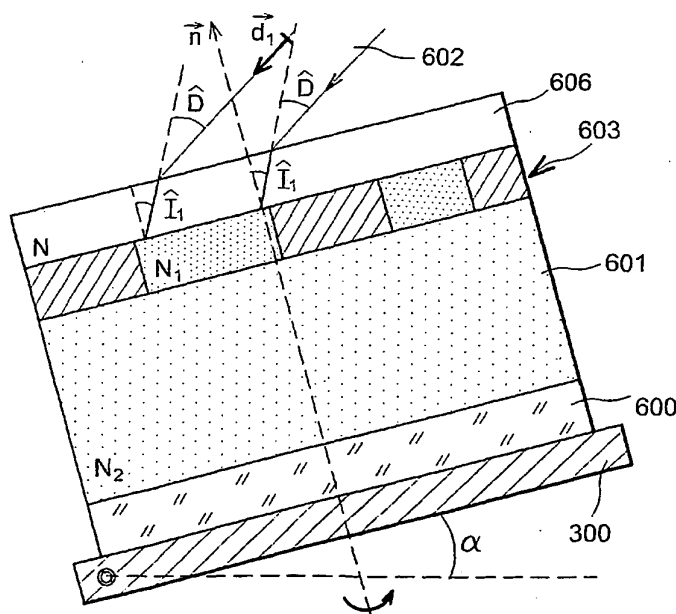
(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: **SMC METHOD FOR PRODUCING INCLINED FLANK PATTERNS BY PHOTOLITHOGRAPHY**

(54) Titre : **PROCEDE DE REALISATION DE MOTIFS A FLANCS INCLINES PAR PHOTOLITHOGRAPHIE**



(57) Abstract: The invention relates to a lithographic method for producing patterns in a photosensitive resin layer (601) placed on a substrate (600). Said patterns (602) comprises flanks (603) inclined with respect to a normal (n) to the main substrate plane forming an inclination angle (θ) which is much greater than the inclination angle of the patterns obtainable by the previous state of the art. A device for carrying out the inventive method is also disclosed.

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/017623 A2

BEST AVAILABLE COPY



ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

- *sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport*

BEST AVAILABLE COPY

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de photolithographie permettant la réalisation de motifs dans une couche de résine photosensible (601) posée sur un substrat (600). Les motifs (607) comprennent des flancs (608) inclinés par rapport à une normale (n) à un plan principal du substrat et qui présentent un angle d'inclinaison (θ) bien supérieur à celui des motifs obtenus selon l'art antérieur. L'invention concerne également un dispositif permettant de mettre en oeuvre ledit procédé.